

ESD Abschirmbeutel metal-in, 75µm, offen, 100Stk. -StatixPro

Beschreibung

Transparenter ESD-Abschirmbeutel metal-in für den zuverlässigen Schutz empfindlicher Elektronik

Der **Metal-In Static Shielding Bag** wurde für die sichere Verpackung und Lagerung empfindlicher elektronischer Bauteile entwickelt. Die transparente, metallisierte Ausführung schützt die verpackten Komponenten vor elektrostatischen Einflüssen und schafft eine definierte ESD-geschützte Umgebung.

Die **vierlagige Konstruktion** aus statischem Polyester, metallisierter Schicht, Polyester sowie statischem Polyethylen/Polystyrol kombiniert elektrostatische Abschirmung mit einer robusten und praxisgerechten Verpackungslösung. Ob Leiterplatten, elektronische Baugruppen oder andere empfindliche Komponenten: Der Metal-In Abschirmbeutel bietet eine praktische Lösung für den ESD-gerechten Umgang mit Elektronik entlang von **Produktion, Lagerung, Transport und Service**.

Ihre Vorteile

- **Effektive ESD-Abschirmung** für empfindliche elektronische Komponenten
- **Chargennummer** Rückverfolgbarkeit
- **Transparente Ausführung** für eine schnelle Sichtkontrolle des Inhalts
- **Vierlagige Materialstruktur** für hohe Schutzwirkung und mechanische Belastbarkeit
- **Schneller statischer Ladungsabbau:** 5000–0 V in < 0,05 s
- **Hohe Durchstichfestigkeit** von >100 psi
- **Hohe Zugfestigkeit** von >18 lb/in
- **Nicht korrosiv** und gemäss Datenblatt geprüft
- **Geringe Wasserdampf- und Sauerstoffdurchlässigkeit**
- Geeignet für den professionellen Einsatz in **Elektronikfertigung, Lagerung, Service und Handel**

Technische Daten

- Zugfestigkeit: > 18 lb/in
- Weiterreissfestigkeit: > 2,5 lb/in
- Durchstichfestigkeit: > 100 psi
- Nahtfestigkeit: 8 lb/in
- Wasserdampfbarriere (MVTR): < 0,2 g/100 in²/24 h
- Sauerstoffbarriere: < 0,5 cc/100 in²/24 h
- Oberflächenwiderstand: < 10¹¹ Ω
- Oberflächenwiderstand innen: 10⁹–10¹¹ Ω
- Oberflächenwiderstand aussen: 10⁸–10¹⁰ Ω
- Widerstand der metallisierten Schicht: < 100 Ω/sq.
- Static Shielding: < 30 V
- Static Shielding Energy: < 10 nJ
- Static Decay (5000–0 V): < 0,05 s
- Kapazitätssondenwert: < 10 V
- Materialstärke: 3 mil, 75µm